# 特殊構造めっき膜を用いた新規接合技術の開発

群馬大学 大学院理工学府 知能機械創製部門

助教 小林 竜也

(2019年度 奨励研究助成(若手研究者枠) AF-2019035-C2)

キーワード:めっき,接合,強度

# 1. 研究の目的と背景

地球環境保護のために省エネルギー化や温室効果ガス 排出削減に関する取組みが進められており,自動車業界に おいては世界各国で厳しい燃費規制が導入されている 1). この規制に対応するためには自動車の軽量化が必須であ り,軽量かつ高強度な部材の需要が高まっている<sup>2)</sup>.単一 材料による軽量・高強度化は困難であるため,異なる複数 の材料を適材適所に用いることで解決を図るマルチマテ リアル化技術が進められており<sup>3)</sup>,これに関連して異種材 料接合技術が不可欠となっている. 従来の異種材料接合技 術では、鉄鋼とアルミニウム合金といった異種金属同士の 接合に関する開発が主であったが、近年では金属とプラ スチックとの接合に関する技術が注目を集めている<sup>4)</sup>.金 属とプラスチックの接合は、一般にボルトや接着剤が用い られるが、重量増加や Volatile organic compounds (VOC, 揮発性有機化合物)による環境負荷への問題があるため, これらに替わる新たな金属-プラスチック異種材料接合技 術が要求されている.

これに対して筆者は、微細な凹凸を持つ特殊構造めっき 膜に着目し、これを用いた金属と熱可塑性プラスチックの 接合技術を発案した.その方法は、金属表面に特殊構造め っき膜を生成した後、その金属を加熱し上部から熱可塑性 プラスチックを搭載し加圧する.これにより、変形した熱 可塑性プラスチックと特殊構造めっき膜はアンカー効果 によって接合がなされる.本接合技術は、大掛かりかつ高 価な装置が不要であること、様々な金属と熱可塑性プラス チックが接合可能であること、凸形状のめっき膜を生成し た金属を熱可塑性プラスチック内部に埋め込む構造であ るため接合時の加圧力が小さく、接合部材の形状や厚さの 制限がないことに利点を持つ.

本研究では、特殊構造めっき膜の生成が可能な Ni-Cu 合金めっきを対象として、電気化学測定によりスルファミ ン酸ニッケルと硫酸銅を混合させた Ni-Cu 合金浴の電析 挙動を評価するとともに、特殊構造めっき膜の生成に及ぼ す電位の影響を調査した. さらに、Ni-Cu 合金浴中のスル ファミン酸ニッケル濃度とめっき時の電流密度を変化さ せたときのめっき膜形状が金属/熱可塑性プラスチックの 接合性に与える影響について調査した.

# 2. 実験方法

## 2・1 めっき浴の電気化学測定

特殊構造めっき膜を生成する Ni-Cu 合金浴の電析挙動

を調査するため,電気化学測定装置を用いて,リニアスイ ープボルタンメトリー (Linear sweep voltammetry: LSV) 法によるカソード分極測定を行った.表1にLSV 試験に使 用しためっき浴組成を示す. No. 1 は硫酸銅浴, No. 2 は スルファミン酸ニッケル浴, No. 3 および No. 4 はスルフ アミン酸ニッケルと硫酸銅を混合させた Ni-Cu 合金浴で ある.電極系について,作用極を Ni めっき板,対極を Pt 線,参照極を Ag/AgC1 電極とした.電気化学測定装置を用 いて,掃引速度 10 mV/s,電位範囲 0~-1.5 V の条件で測 定を行った.

次に,電位を一定にして Ni-Cu めっき膜の生成を行った. 条件は,電位を-0.5, -1.0 V にそれぞれ固定した.めっ き膜の生成後, SEM を用いてめっき膜の表面および断面観 察を実施した.

## 2・2 接合試験片作製と引張せん断試験

特殊構造めっきを用いた金属と熱可塑性プラスチック の接合性を調査するため、引張せん断試験による接合強度 評価を実施した.供試材として、SUS304(10×45×1.5 mm<sup>3</sup>、 1000 番研磨)とポリアミド6 (PA6、10×45×3.0 mm<sup>3</sup>)の 板材を用意した.はじめに、塩化ニッケル 200 g/L、塩酸 100 ml/Lのウッド浴を用いて、電流密度 50 mA/cm<sup>2</sup>、時間 3 min の条件で SUS304 板上に Ni めっき膜を生成した.こ こで、めっき部位の開口面積を 10×5 mm<sup>2</sup> とした.次に、 Ni-Cu 合金浴を用いて特殊構造めっき膜を生成した.表 2 に使用した Ni-Cu 合金浴の組成を示す.浴中のスルファミ ン酸ニッケル濃度を 150、300、450 g/L とし、電流密度 10 mA/cm<sup>2</sup>、時間 20 min および 100 mA/cm<sup>2</sup>、2 min の 2 条 件で実施した.Ni-Cu めっき膜の生成後、FE-SEM と EPMA を用いてめっき膜の表面および断面観察、定量分析を行っ た.

表1 LSV 試験用めっき浴組成

	濃度 [g/L]			
彩出. 万义.	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4
Ni (NH <sub>2</sub> SO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> · 4H <sub>2</sub> O	0	150	150	450
$CuSO_4 \cdot 5H_2O$	15	0	15	15
$H_3BO_3$	30	30	30	30
$C_7H_4NNaO_3S \cdot 2H_2O$	0.2	0.2	0.2	0.2

表 2 SUS304/PA6 接合用 Ni-Cu 合金浴組成

名中	濃度 [g/L]			
术且,月又。	No. 5	No. 6	No. 7	
Ni (NH <sub>2</sub> SO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> · 4H <sub>2</sub> O	150	300	450	
$CuSO_4 \cdot 5H_2O$	15	15	15	
$H_3BO_3$	30	30	30	
$C_7H_4NNaO_3S \cdot 2H_2O$	0.2	0.2	0.2	

次に、特殊構造めっき膜が付与された SUS304 板をホッ トプレート上で200℃に加熱し、その上に PA6 板を載せて 荷重をかけることで接合を行った. 接合条件は、荷重を 5.0 N、接合時間を5 min とした. 図1に引張せん断試験 片の形状および寸法を示す. 試験片作製後、万能材料試験 機を用いて、IS019095 に基づいて引張せん断試験を実施 した. 引張速度は10 mm/min, 試験温度は室温とした. ま た, 試験数を1条件あたり5本とした. 引張せん断試験 後、光学顕微鏡を用いて SUS304 板および PA6 板の破断面 を観察し破断位置を推定した.

#### 3. 実験結果

# 3・1 電気化学測定結果

図 2 に電気化学測定によって得られた各浴組成におけ る LSV 曲線を示す. グラフの横軸は電位, 縦軸は電流密度 である.浴組成 No. 1 の硫酸銅浴について、0 V から負電 位が大きくなるにつれて電流密度が増加し、-0.3 V 以降 では緩やかな増加で推移した.これは、浴中に含まれる Cuイオン濃度が低く拡散限界が生じたからである. No. 2 のスルファミン酸ニッケル浴について、Ni イオンの還元 開始点は約-0.8 V であり、それ以降の電位で電流密度は 急激に増加した. これより, Ni の生成は電荷移動によっ て制御されていることがわかる. No. 3のスルファミン酸 ニッケル濃度 150 g/LのNi-Cu合金浴では,-0.13 V でピ ークが見られるが、これは Cu<sup>2+</sup>が金属 Cu に還元されたこ とに相当する<sup>5)</sup>. また, Ni-Cu めっき膜は-0.8V 以降の電 位で形成され、負電位の上昇に伴い Ni の生成速度が増加 した. No. 4 のスルファミン酸ニッケル濃度 450 g/L の Ni-Cu 合金浴では、No. 3 と同様に-0.8 V 以降の電位で電 流密度が急激に上昇しているが、傾きは No. 4 の方が大き い. したがって、-0.8 V 以降では、No. 4 は No. 3 より Ni の生成速度が大きいことが考えられる.

図3に浴組成No.3のNi-Cu合金浴における電位-0.5V, -1.0Vで生成しためっき膜の表面および断面SEM像を示 す.これより,電位-0.5Vでは平滑なめっき膜が,-1.0V では樹状の三次元構造体を持つめっき膜が生成すること を確認した.このことから,特殊構造めっき膜の形成は, 電位に依存していることがわかる.Ni-Cu合金浴で三次元 構造体が形成されるメカニズムは以下の通りである.Cu の電極電位はNiよりも貴であるため,通電初期はCu結晶



図1 引張せん断試験片の形状および寸法(単位:mm)





10 µm

の核が板上に生成される. その後,板近傍では Cu の生成 により Cu イオンが枯渇し, Cu イオンはバルク溶液から最 短拡散距離である Cu 結晶核上部で還元される. これによ り,高さ方向にめっきが成長していく. 一方 Ni は,浴中 の Ni イオンは豊富に存在するために板全面に生成し,ま た,横方向への Cu の成長を抑制する. これらの現象によ って,めっき膜に三次元構造体が形成される. 以上より, スルファミン酸ニッケルと硫酸銅を混合させた Ni-Cu 合 金浴において,高負電位を印加することで三次元構造体を 有するめっき膜が生成されることがわかった.

#### 3・2 SUS304 上の特殊構造めっき膜の観察結果<sup>6)</sup>

図4にSUS304板上に生成したNi-Cuめっき膜の表面お よび断面SEM像を示す.ここで,(a)は電流密度10mA/cm<sup>2</sup> (電位換算で約-0.84 V),(b)は100mA/cm<sup>2</sup>(約-1.4 V) である.図より,全ての条件で樹状の三次元構造体が形成 されていた.また,(a)より,浴組成No.6やNo.7とい ったスルファミン酸ニッケル濃度が高いNi-Cu合金浴で は樹状構造体の幹枝部が太く形成されることを確認した. (b)より,No.5では(a)と同じ樹状構造体が生成されて いた.しかしながら,No.6とNo.7では,背低な樹状構 造体が形成されていた.これは,高電流密度によるNi生



(a) 電流密度 10 mA/cm<sup>2</sup>



(b)電流密度 100 mA/cm<sup>2</sup> 図 4 特殊構造めっき膜の表面および断面 SEM 像<sup>6)</sup>

成速度の上昇により、板全面が Ni めっきに覆われ、樹状 構造体の高さ方向の生成が阻害されたためと考える.表3 に、図4の各断面 SEM 像に示した点 A~L における Ni お よびCuの組成の定量分析結果を示す.図 4(a)の No.5よ り、樹状構造体の先端部に示す点 A の Ni と Cu の組成 はそれぞれ 9.9%と 90.1%であった. また、樹状構造体の 根元部に示す点 BのNiとCuの組成は、それぞれ 97.5%と 2.5%であった.これより、樹状構造体の先端部では Cu の 組成が高く,根元部ではNiの組成が高いことがわかった. これは上述の通り、Cu は高さ方向に、Ni は板全面に生成 したことが要因と考える.図 4(a)において、浴中のスル ファミン酸ニッケル濃度が高くなるにつれて、先端部の Ni 組成が高くなることを確認した. また, 図 4(b)では, めっき膜全体において Ni 組成が高い傾向を示した. これ は、電流密度が増加することで Ni の生成速度が増加し、 樹状構造体と板全面に Ni めっきが生成されたからである.

図 5 に特殊構造めっき膜を介して接合した SUS304/PA6 の接合界面の断面 SEM 像を示す.図より,全ての条件で樹 状構造体が PA6 に覆われていることを確認した.一方,PA6 内部では,樹状構造体直上に 30~200 µm サイズのボイド が形成されていた.このボイドは,接合時の加熱による樹 脂の熱分解が要因と考える<sup>7)</sup>.

表3 定量分析結果 6)

Position	Ni [at.%]	Cu [at.%]	Position	Ni [at.%]	Cu [at.%]
А	9.9	90.1	G	6.9	93.1
В	97.5	2.5	Н	93.2	6.8
С	46.1	53.9	Ι	66.9	33.1
D	90.1	9.9	J	86.9	13.1
Е	56.3	43.7	Κ	73.3	26.7
F	96.5	3.5	L	90.7	9.3

No.	5	6	7
断面	PA6 ボイド	ボイド	ж
10 <sup>-</sup> µm	SUS304		

(a) 電流密度 10 mA/cm<sup>2</sup>



(b)電流密度 100 mA/cm<sup>2</sup>
図 5 SUS304/PA6 接合界面の断面 SEM 像<sup>6)</sup>

## 3·3 SUS304/PA6 接合強度評価結果

図6に引張せん断試験で得られたSUS304/PA6の接合強 度の評価結果を示す<sup>6)</sup>. 左右のグラフは、それぞれ電流密 度10 mA/cm<sup>2</sup>, 100 mA/cm<sup>2</sup>の条件で生成した特殊構造めっ き膜を用いたときの接合強度を示している.図より、全て の条件において平均接合強度が10 MPa以上を示した.こ の接合強度は、エポキシ系接着剤で接合した場合とほぼ同 等である<sup>8)</sup>. また、10 mA/cm<sup>2</sup>においては、浴中のスルフ アミン酸ニッケル濃度が高いほど接合強度は高い傾向を 示した.さらに、10 mA/cm<sup>2</sup> で生成した特殊構造めっき膜 を有する引張せん断試験片の接合強度は、100 mA/cm<sup>2</sup>で生 成したものよりも高い傾向にあった.特に、浴組成 No.7、 10 mA/cm<sup>2</sup> で作製された試験片は、得られた平均接合強度 が 17 MPa であり、今回実施した条件の中で最も高い強度 を示した.

図 7 に引張せん断試験後の試験片断面の光学顕微鏡像 を示す. (a)は電流密度 10 mA/cm<sup>2 6)</sup>, (b)は 100 mA/cm<sup>2</sup>で ある. 全ての条件において, PA6 板側でめっき膜である樹 状構造体の一部が観察された. また, SUS304 板側では, PA6 残渣と樹状構造体の根元部が観察された. したがって, これらの破壊モードは, PA6 およびめっき膜(樹状構造体) の混合破壊である.

図 8 に各条件における試験片の破断経路の模式図を示 す.(a)より、スルファミン酸ニッケルと硫酸銅の濃度比 150:15 (g/L)、電流密度 10 mA/cm<sup>2</sup>では、試験片は樹状 構造体、PA6、ボイドを伝って破断する.このとき、形成 された樹状構造体は細く破断しやすいため、接合強度は低 い.一方、(b)より、スルファミン酸ニッケルと硫酸銅の 濃度比 300~450:15 (g/L)、電流密度 10 mA/cm<sup>2</sup>では、(a) と同様に混合破壊であるが、樹状構造体は太いため、破断 しにくく接合強度は高い.(c)より、スルファミン酸ニッ ケルと硫酸銅の濃度比 300~450:15 (g/L)、電流密度 100 mA/cm<sup>2</sup>では、低背な樹状構造体、PA6、ボイドを伝って破 断するが接合強度は低い.



図 6 SUS304/PA6 の接合強度測定結果<sup>6)</sup>



10 μ

(a) 電流密度 10 mA/cm<sup>2 6)</sup>



(b) 電流密度 100 mA/cm<sup>2</sup>図7 引張せん断試験片の破断面観察結果

	(a)	(b)	(c)
濃度比	150:15	300-450:15	300-450:15
電流密度	$10 \text{ mA/cm}^2$	$10 \text{ mA/cm}^2$	$100 \text{ mA/cm}^2$
断面模式図	ボイド 破面 PA6 SUS304 めっき膜(樹状構造体)	¥-Ý	······

図8 各条件における破断経路の模式図

# 4. 結言

本研究では、電気化学測定によりスルファミン酸ニッケ ルと硫酸銅を混合させた Ni-Cu 合金浴の電析挙動を調査 し、さらに、浴中のスルファミン酸ニッケル濃度および電 流密度を変化させたときのめっき膜形状が SUS304/PA6 の 接合性に与える影響を評価した.浴中のスルファミン酸ニ ッケルと硫酸銅の濃度比を 150:15 (g/L)、電位を-1.0 V にしたとき、三次元構造体を有する Ni-Cu めっき膜が生成 されることがわかった.また、Ni-Cu めっき膜が付与され た SUS304 板と PA6 板を加熱加圧によって接合すると、PA6 内部にはボイドが形成された.浴中のスルファミン酸ニッ ケルと硫酸銅の濃度比 450:15 (g/L)、電流密度 10 mA/cm<sup>2</sup> の条件で生成された Ni-Cu めっき膜を用いて接合した SUS304/PA6 せん断引張試験片の平均接合強度は 17 MPa で あり、今回実施した条件の中で最も高い強度を示した.

# 謝 辞

「特殊構造めっき膜を用いた新規接合技術の開発」に対 して研究費を助成して頂いた天田財団には心よりお礼申 し上げます.特殊構造めっき膜の生成メカニズムを明らか にするためには本研究費がなければ成し遂げられません でした.一方で,特殊構造めっき膜を用いた低温接合につ いては接合強度が実用性に至っていないため,今後も引き 続き研究を進めて参ります.

# 参考文献

- D. Kodjak, B. Sharpe, and O. Delgado: Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 20 (2015), 755-775.
- T. Lee, J. Lee, D. Lee, I. Jo, S.K. Lee, and H.J. Ryu: Journal of Alloys and Compounds, 831 (2020), 154647.
- J. Korta, A. Mlyniec, and T. Uhl: Composites Part B, 79 (2015), 621-630.
- F. Lionetto, F. Balle, and A. Maffezzoli: Journal of Materials Processing Technology, 247 (2017), 289-295.
- J.K. Chang, S.H. Hsu, I.W. Sun, and W.T. Tsai: Journal of Physical Chemistry C, 112 (2008), 1371-1376.
- T. Kobayashi and I. Shohji: Materials and Manufacturing Processes, 36 (2021), 1076-1083.
- J. Jiao, Q. Wang, F. Wang, S. Zan, and W. Zhang: Journal of Materials Processing Technology, 240 (2017), 362-369.
- P. Jojibabu, M. Jagannatham, P. Haridoss, G.D. Janaki Ram, A.P. Deshpande, and S.R. Bakshi: Composites Part A, 82 (2016), 53-64.